



بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و  
فوتوونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس  
مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،  
دانشگاه سیستان و بلوچستان،  
 Zahedan, Iran.  
 ۱۴-۱۶ بهمن ۱۳۹۹



کد مقاله : A-۱۰-۲۴۷۸-۱

## بهبود جذب نور در آرایه‌های نیمه‌متناوب سلول‌های خورشیدی نانوسيم مستطيلي سيلikon بي‌شكلي / كريستالي

سيده ليلا مرتضوي فر<sup>۱\*</sup>، مجتبى شهركى<sup>۲</sup>، محمدرضا صالحى<sup>۱</sup>، ابراهيم عبيرى<sup>۱</sup>

<sup>۱</sup> شيراز، بلوار مدرس، دانشگاه صنعتي شيراز،

<sup>۲</sup> زاهدان، خيابان دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان

\* l.mortazavifar@sutech.ac.ir

چكideh - در اين مقاله، جذب نوري سلول‌های خورشیدی مستطيلي سيلikon بي‌شكلي شده است که بين لاييه‌های سيلikon كريستالي محصور شده است. ساختار پيشنهادی در مقایسه با ديجر سلول‌های خورشیدی نانوسيم دارای هندسه بسيار ساده بوده، در حالی که ميزان جذب آن با ساختارهای بسيار پيچيده قابل مقایسه است. برای دستيابي به جذب پهن‌باند از نانو سيم‌هاي مستطيلي شكل دوره‌اي و نيمه دوره‌اي استفاده می‌شود. به منظور به حداقل رساندن چگالی جريان اتصال کوتاه سلول خورشیدي نانوسيم پيشنهادی، الگوريتم بهينه‌سازی ازدحام ذرات استفاده شده است. نتایج نشان‌دهنده افزایش ۹۶ درصدی چگالی جريان اتصال کوتاه در مقایسه با ساختار فيلم نازک مسطح بهينه‌شده است.

کلید واژه- جذب نوري، جريان اتصال کوتاه، آنتن نوري، سيلikon، نانوسيم

### Absorption improvement in semi-periodic arrays of a-si/c-si Solar cells

SeyedehLeila Mortazavifar<sup>1,\*</sup>, Mojtaba Shahraki<sup>2</sup>, Mohammad Reza Salehi<sup>1</sup>, Ebrahim Abiri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Shiraz University of Technology, Modarres Blvd, Shiraz, IRAN.

<sup>2</sup>University of Sistan and baluchestan, Daneshgah Blvd, Zahedan, IRAN.

\* l.mortazavifar@sutech.ac.ir

**Abstract-** In this paper, optical absorption of rectangular a-Si/c-Si solar cells is investigated. Each Nanowire is consisted of a thin layer of a-si, which surrounded by c-si layers. The proposed structure has a very simple geometry compared to other nanowire solar cells, while its absorption rate is comparable to very complex structures. Periodic and semi-periodic rectangular nanowires are used to achieve broadband absorption. In order to maximize the short-circuit current density of the proposed nanowire solar cells; particle swarm optimization (PSO) algorithm has been performed. The results show 96% increase in short-circuit current density compared to the optimally thin film structure.

Keywords: Optical Absorption, Short Circuit Current Density, Nano Antenna, Silicon, Nanowire

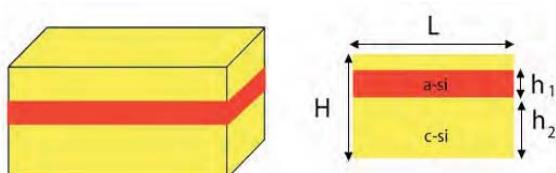
در ادامه مقاله، آرایه‌های مستطیل شکل دوره‌ای و نیمه دوره‌ای c-Si/a-Si بررسی شده‌اند. سپس، از چند NWs با هندسه‌های مختلف برای رسیدن به جذب پهن‌باند استفاده شده است. سرانجام، از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) برای بهینه‌سازی پارامترهای سلول‌های پیشنهادی استفاده گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از NW های مستطیلی نیمه دوره‌ای منجر به جذب پهن‌باند در داخل SC می‌شود.

### مدل نظری

در این مقاله، جذب نوری سلول‌های خورشیدی نانوسيم مستطيلی سيليكون c-Si / a-Si مورد بررسی قرار گرفته است. همانطور که در شکل ۱ نشان داده شده است، هر نانوسيم از یک لایه نازک سيليكون آمورف تشکيل شده است که بین دو لایه سيليكون بلوري قرار گرفته است. ضخامت لايسيليكون آمورف ۲۵ نانومتر تنظيم شده است [۴]. اين لایه به اندازه کافی نازک است که تأثيرات منفي سيليكون آمورف بر خصوصيات الکترونيکياني و ايرقابل اغمض است.

به منظور جلوگيري از نفوذ نانوسيم‌ها، از یک لایه ميانی SiO<sub>2</sub> بين هرنانو و اير استفاده شده است [۴]. علاوه بر اين، سطح نانو و اير نيز با SiO<sub>2</sub> به عنوان يك پوشش ضد انعکاس پوشش داده شده است.

فرض بر اين است که نور خورشيد از قطبش‌های الکتروني متقطع(TE) و مغناطيسي متقطع(TM) تشکيل شده است.



شکل ۱: هندسه مقطعی نانوسيم

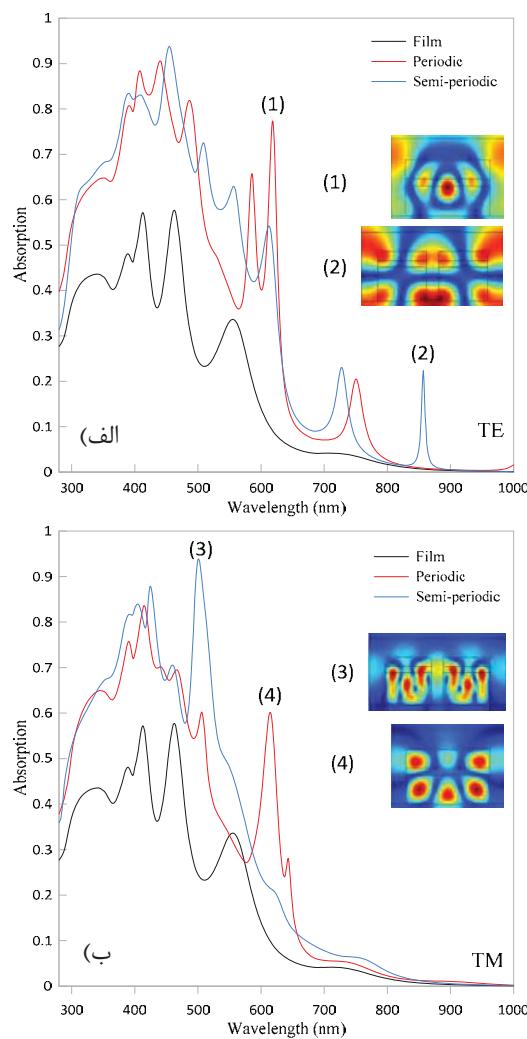
### مقدمه

سلول‌های خورشیدی در چندسال اخیر توجه زیادی را در تحقیقات علمی بهدلیل مزایای فراوان مانند سودآوری، سبکوزن بودن و سادگی ساخت، به خود جلب کرده‌اند. با این حال، بازده کم اينسلول‌ها برای کاربرد عملیک چالش مهم می‌باشد. از این رو افزایش عملکرد سلول‌های خورشیدی همواره مشکلی است که در حین طراحی، باید به آن پرداخته شود. دستکاری رفتار نور برای بیشینه ساختن میزان جذب خورشیدی، روش کلیدی برای افزایش اثربخشی سلول‌های خورشیدی است [۳-۱].

استفاده از نانوسيم‌ها (NW) در سلول‌های خورشیدی (SC) به دليل ويزگي‌های نوری قابل توجه NW‌های نيمه‌هادی از جمله جذب پهن‌باند و امكان تنظيم طيف جذب، توجه روزافروني را به خود جلب کرده است. مهم‌تر از همه، فناوري NW هزينه توليد SC را به دليل کاهش استفاده از مواد كمتر می‌کند.

سلول‌های لایه نازک از یک لایه نازک نیمه‌رسانا برای جذب فوتون‌ها استفاده می‌کنند. اولین سلول لایه نازک ساخته شده از نوع آمورف بود. اين سلول به دليل بازدهی کم و همچنین نرخ رسوب بالا نتوانست موفق ظاهر شود. آنجا كه طول انتشار حامل‌ها در a-Si نسبتاً کم است، اثرات مخربی بر خصوصيات الکترونيکي SC دارد.

به همين دليل، سيليكون بلوري (c-Si) و سيليكون بي‌شكل(a-Si) برای استفاده از طول انتشار حامل بالاي c-Si و همچنین ضريب جذب بالاي a-Si استفاده شده است [۱,۲]. در اين مقاله استفاده از نانوسيم‌ها آرایه‌ای مستطيل شکل به عنوان ابزاری جهت افزایش بازدهی سلول خورشیدی پیشنهاد شده است. اين سلول‌ها ساختار بسيار ساده‌ای داشته و در مقایسه با سلول‌های نانوسيم با ساختارهای پيچيده نتایج خوبی را ارائه می‌دهند.



شکل ۲: طیف جذب آرایه‌های مستطیل دوره‌ای و نیمه دوره‌ای پیشنهادی و فیلم نازک SC، برای قطبیش (a) TE و (b) TM.

مدھای کاواک (Cavity Modes) برای قطبیش TM و TE برای قطبیش (whispering gallery modes) منجر به افزایش جذب آرایه‌های مستطیل گون پیشنهادی می‌شود. طیف جذب برای آرایه دوره‌ای NW مستطیل گون پیشنهادی برای قطبیش TE و TM، در شکل ۳ نشان داده شده است.

### آرایه‌های نانوسیم مستطیلی نیمه دوره‌ای

با توجه به شکل ۲ قسمت (b) برای بهبود جذب NW سلول خورشیدی مستطیلی، از ساختار NW نیمه دوره‌ای استفاده شده است.

با استفاده از طیف جذب و با فرض کارایی کامل کوانتمی داخلی، می‌توان چگالی جریان اتصال کوتاه سلول خورشیدی را با استفاده از رابطه (۱) بدست آورد [۶].

$$(1) J_{sc} = \int_{\lambda m_1}^{\lambda m_2} \frac{q\lambda}{hc} I(\lambda) A(\lambda) d\lambda$$

در این حالت،  $q$  بار الکترون،  $\lambda$  طول موج نور خورشید، ثابت پلانک،  $c$  سرعت نور و  $\lambda m_1, \lambda m_2$  بابه حداقل و حداقل طول موج اشاره دارند که به ترتیب برابر با  $280$  و  $1000$  نانومتر هستند  $I(\lambda)$ . جذب نور سلول خورشیدی و  $A(\lambda)$  شدت تابش جهانی طیف خورشید است که با نشان داده می‌شود [۷].

### آرایه‌های فیلم نازک

در این آرایه ضخامت لایه سیلیکون آموف ۲۵ نانومتر و ضخامت کل ساختار ۲۰۰ نانومتر تنظیم شده است. PSO پارامترهای بهینه این سلول با استفاده از الگوریتم بهصورت  $h_2=124$  و  $t_{arc}=151/4$  nm  $L=309.5$  nm بود. در نتیجه  $5.32$  nm بدست می‌آیند که منجر به چگالی جریان  $mA/cm^2$  می‌شود. در شکل ۲، طیفهای جذب فیلم نازک رسم شده است.

### آرایه‌های نانوسیم مستطیلی دوره‌ای

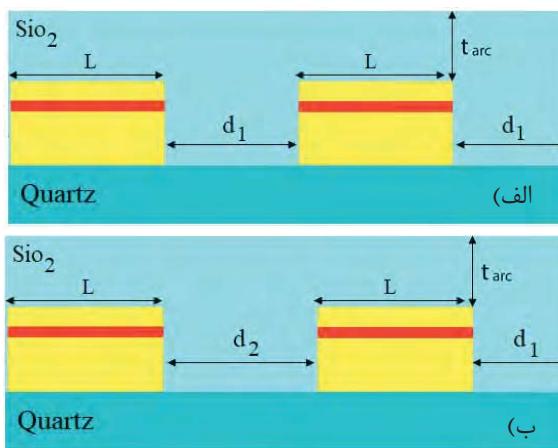
برای جذب بهتر نور، شکل ۳(الف) آرایه‌های دوره‌ای NW مستطیل گون پیشنهادی در بالای بستری از کوارتز با ضخامت کافی قرار می‌گیرند. به دلیل وابستگی زیاد خصوصیات نوری سلول‌های خورشیدی به پارامتر هندسی نانوسیم، از الگوریتم PSO برای استخراج حداقل چگالی جریان استفاده می‌شود. پارامترهای بهینه در جدول (۱) آورده شده است. در مقایسه با فیلم نازک، آرایه‌های دوره‌ای NW مستطیل گونه پیشنهادی جذب بالاتری برای قطبیش TE و TM دارند. یک تشدید قوی در حدود  $65\%$  عنانومتر برای قطبیش TM وجود دارد.

## نتیجه گیری

در این مقاله، برای افزایش چگالی جریان سلول‌های خورشیدی از یک آرایه c-Si/a-Si استفاده شده است و جذب نور در آرایه‌های مستطیل‌گونه دوره‌ای و نیمه‌دوره‌ای بررسی شده است. به منظور به حداقل رساندن چگالی‌جریان اتصال کوتاه سلول خورشیدی، الگوریتم بهینه‌سازی برای تمام ساختارهای پیشنهادی اعمال می‌شود. نتایج محاسبه نشان داد که آرایه‌های مستطیل شکل دوره‌ای بهینه شده علاوه بر اینکه افزایش جذب بهتری در مقایسه با فیلم نازک دارد، حالت‌های تشديد جدیدی را نیز ایجاد می‌کند. ساختار پیشنهادی نیمه‌دوره‌ای در مقایسه با سلول فیلم نازک افزایش ۹۶ درصدی داشته است.

## مراجع

- [1] F. F. Mahani and A. Mokhtari, "TiO<sub>2</sub> circular nanogratings as anti-reflective coatings and potential color filters for efficient organic solar cells," Journal of nanoelectronics and optoelectronics, vol. 13, no. 11, pp. 1624-1629, 2018.
- [2] Y. Gao, F. Jin, Z. Su, H. Zhao, Y. Luo, B. Chu, and W. Li, "Cooperative plasmon enhanced organic solar cells with thermal coevaporated Au and Ag nanoparticles," Org. Electron. 48, 336–341 (2017).
- [3] P. T. Dang, T. K. Nguyen, and K. Q. Le, "Revisited design optimization of metallic gratings for plasmonic light-trapping enhancement in thin organic solar cells," Opt. Commun. 382, 241–245 (2017).
- [4] M. Gwon, Y. Cho, and D.-W. Kim, "Design of surface nanowire arrays for high efficiency thin ( $\leq 10$  mm) Si solar cells", Curr. Appl. Phys., Vol. 15, pp. 34-37, Jan. 2015.
- [5] M. Shahraki, M.R. Salehi, and E. Abiri, "Optimal design of laterally assembled hexagonal silicon nanowires for broadband absorption enhancement in ultrathin solar cells", Opt. Eng., Vol. 54, pp. 115102, Nov. 2015.
- [6] Yan, X.; Liu, H.; Sibirev, N.; Zhang, X.; Ren, X. "Performance Enhancement of Ultra-Thin Nanowire Array Solar Cells by Bottom Reflectivity Engineering. Nanomaterials" 2020, 10, 184.



شکل ۳. آرایه‌های نانوسیم‌مستطیلی (الف) دوره‌ای (ب) نیمه دوره‌ای

در ساختار نیمه دوره‌ای، اثر آنتن نوری و اثر پراش را می‌توان با تغییر فضای بین هر NW کنترل کرد. با هدف به حداقل رساندن جریان اتصال کوتاه ( $J_{SC}$ ) از الگوریتم PSO برای بهینه‌سازی ساختار پیشنهادی استفاده می‌شود. پارامترهای بهینه در جدول (۱) آورده شده است.

طیف جذب آرایه‌های فیلم نازک، دوره‌ای و نیمه دوره‌ای NW در شکل ۲ مقایسه شده است. چگالی کل جریان سلول‌های خورشیدی در درجه اول با نسبت منطقه سیلیکون پیش‌بینی شده تعیین می‌شود. با این وجود، حداقل چگالی جریان موثر نتیجه هر دو اثر پراش و آنتن نوری است. در جدول (۱) مقدار محاسبه شده پارامترهای بهینه شده برای ساختارهای مختلف پیشنهادی همراه با افزایش  $J_{SC}$  در مقایسه با نانوسیم فیلم نازک ارائه شده است.

جدول ۱: پارامترهای بهینه شده

| Structure                      | Thin film | Periodic | Semiperiodic |
|--------------------------------|-----------|----------|--------------|
| $L$                            | 309.5     | 301.3    | 196.6        |
| $d_1$                          | -         | 102.3    | 132.7        |
| $d_2$                          | -         | -        | 50.1         |
| $h_2$                          | 151.4     | 76.1     | 78.2         |
| $J_{SC}$ (mA/cm <sup>2</sup> ) | 124       | 108      | 137          |
| $J_{SC}$ (mA/cm <sup>2</sup> ) | 5.32      | 9.853    | 10.45        |

[7]Peter Amalathas, A.; Alkaisi, M.M. "Nanostructures for light trapping in thin film solar cells. Micromachines" 2019, 10, 619.